

CLL4150

**SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE**



SOD-80 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CLL4150 type is an ultra-high speed silicon switching diode manufactured by the epitaxial planar process, in a hermetically sealed glass surface mount package, designed for high speed switching applications.

MARKING: CATHODE BAND

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Continuous Reverse Voltage
Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL		UNITS
V_R	50	V
V_{RRM}	50	V
I_F	300	mA
I_{FRM}	600	mA
I_{FSM}	4.0	A
I_{FSM}	1.0	A
P_D	500	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}	350	$^\circ\text{C/W}$

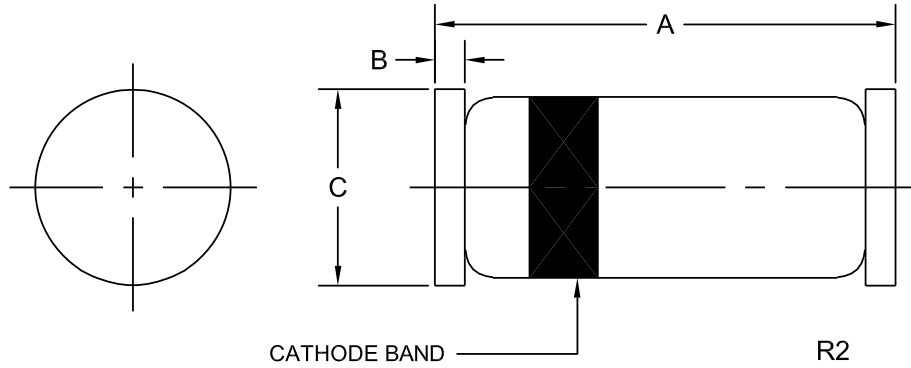
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=50\text{V}$		100	nA
BV_R	$I_R=5.0\mu\text{A}$	75		V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$	0.54	0.62	V
V_F	$I_F=10\text{mA}$	0.66	0.74	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$	0.76	0.86	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$	0.82	0.92	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$	0.87	1.0	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{ MHz}$		4.0	pF
t_{rr}	$I_R=I_F=10\text{mA}, R_L=100\Omega, \text{Rec. to } 1.0\text{mA}$		4.0	ns

CLL4150
SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE



SOD-80 CASE - MECHANICAL OUTLINE



MARKING: CATHODE BAND

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.130	0.146	3.30	3.71
B	0.014		0.35	
C (DIA)	0.049	0.067	1.25	1.70

SOD-80 (REV:R2)

R3 (8-January 2010)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А